

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000 - 258517

(P 2 0 0 0 - 2 5 8 5 1 7 A)

(43)公開日 平成12年 9月22日 (2000.9.22)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マコード (参考)
G01R 33/02		G01R 33/02	D 2G017
G11B 5/33		G11B 5/33	
H01L 27/22		H01L 27/22	
43/00		43/00	

審査請求 未請求 請求項の数 7 O L (全 6 頁)

(21)出願番号 特願平11 - 62530

(22)出願日 平成11年 3月10日 (1999.3.10)

特許法第30条第 1 項適用申請有り 1998年 9月21日 ~ 9月22日 電気学会東海支部他共催の「平成10年度電気関係学会東海支部連合大会」において文書をもって発表

(71)出願人 396020800

科学技術振興事業団

埼玉県川口市本町 4 丁目 1 番 8 号

(72)発明者 毛利 佳年雄

愛知県名古屋市天白区島田黒石1213番地

(74)代理人 100089635

弁理士 清水 守

F タ-ム (参考) 2G017 AA01 AB05 AC04 AC09 AD42

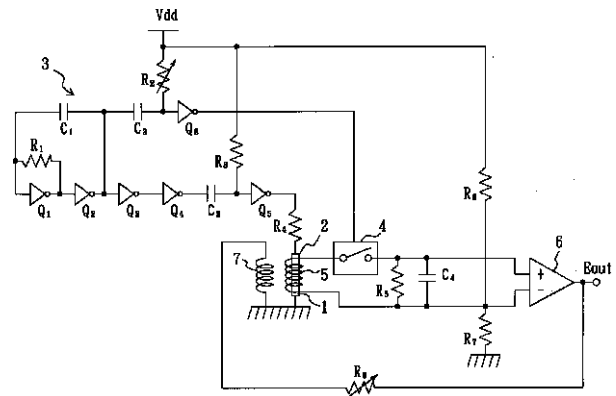
AD51 BA05

(54) 【発明の名称】 磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサ

(57) 【要約】

【課題】 温度特性の安定化を図るとともに、消費電力を減少させることができる磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサを提供する。

【解決手段】 磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサにおいて、パルス通電電流で周回方向に励磁される高透磁率磁性体ヘッド 2 と、この高透磁率磁性体ヘッド 2 の周回方向に巻回されたコイル 5 と、このコイル 5 の誘起電圧の第 1 パルスを検出する電子スイッチ 4 とを具備する。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】(a) パルス通電電流で周回方向に励磁される高透磁率磁性体ヘッドと、(b) 該高透磁率磁性体ヘッドの周回方向に巻回されたコイルと、(c) 該コイルの誘起電圧の第 1 パルスを検出する電子スイッチとを具備することを特徴とする磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサ。

【請求項 2】 請求項 1 記載の磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサにおいて、前記高透磁率磁性体ヘッドはアモルファス磁性体を用いた磁性体ヘッドであることを特徴とする磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサ。

【請求項 3】 請求項 2 記載の磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサにおいて、前記アモルファス磁性体ヘッドはアモルファスワイヤであることを特徴とする磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサ。

【請求項 4】 請求項 1、2 又は 3 記載の磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサにおいて、前記高透磁率磁性体ヘッドは、周回方向に磁気異方性を持つヘッドであることを特徴とする磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサ。

【請求項 5】 請求項 1 記載の磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサにおいて、前記パルス通電電流は、前記高透磁率磁性体ヘッドに表皮効果を生じさせ、磁気インピーダンス効果を生じさせることを特徴とする磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサ。

【請求項 6】 請求項 1 記載の磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサにおいて、前記電子スイッチに接続されるアンプからのセンサ出力電圧に比例した電流を印加させ、外部磁界 H_x を相殺する負帰還磁界を発生する帰還コイルとを具備することを特徴とする磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサ。

【請求項 7】 請求項 1 又は 6 記載の磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサにおいて、前記高透磁率磁性体ヘッドを 2 ヘッドとなし、コモンモード相殺効果による温度安定性を高めることを特徴とする磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサ。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】本発明は、微小磁界を温度安 40

磁界センサ	ヘッド寸法	分解能	応答周波数	消費電力
フラックスゲートセンサ	20 mm	$10^{-6}G$	数 kHz	10 VA
MI センサ	1 mm	$10^{-8}G$	MHz	10 mW

【 0 0 0 8 】このように、MI センサはマイクロ寸法ヘッド、高感度、高速応答、低消費電力の 4 つの長所をすべて兼備する超高性能マイクロ磁気センサであるため、電磁波センサ、電磁波信号解析器、地磁気方位センサ、

定性が高く、かつ、高感度・高速応答で検出する磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサに関するものである。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】従来の高感度磁気センサとしては、フラックスゲートセンサ及び既に本願発明者によって提案されている磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサ (MI センサ) がある (例えば、特開平 9 - 1 3 3 7 4 2 号公報、特開平 9 - 3 2 9 6 5 5 号公報参照) 。

10 【 0 0 0 3 】フラックスゲートセンサは、アポロ計画で月磁気検出に用いられたことで有名な高感度磁界センサであるが、ヘッドの長さ方向に交流磁界で励振することによるヘッド端部の反磁界の影響を避けるため、ヘッドの長さを、20 ~ 30 mm に設定して、ヘッドの中央部の磁束変化の外部磁界に対する感応性を利用して、マイクロガウスの高分解能を実現している。

20 【 0 0 0 4 】この原理的欠点のため、フラックスゲートセンサでは、ヘッドのマイクロ寸法化は不可能であり、ヘッド端部の磁界検出感度が低い磁気記録のヘッドや、高密度着磁体の表面局所磁界を検出するロータリーエンコーダ用ヘッドなどには適用できない。専ら、一樣磁界に対してのみ高感度である。応答速度は、コイルによる大振幅励磁のため数 kHz が一般的であり、数十 kHz 以上の磁界を検出することは困難である。さらに、この大振幅励磁のため、消費電力は 10 VA 以上であり、携帯性には難がある。

30 【 0 0 0 5 】一方、MI センサは、ヘッドの磁性体に高周波電流またはパルス電流を通電して表皮効果を生じさせることにより、そのインピーダンスが外部磁界で敏感に変化することを原理としており、反磁界を生じないため、ヘッドを 1 mm 以下のマイクロ寸法に短く設定してもマイクロガウスの磁界検出分解能を發揮し、MHz の高速応答も容易であり、さらに、パルス電流励磁・パルス磁界バイアス方式 MI センサの消費電力は 10 mW 程度であるので、携帯性に富んでいる。

【 0 0 0 6 】表 1 に、フラックスゲートセンサと MI センサの基本性能の比較を示す。

【 0 0 0 7 】

【表 1】

ハンディ地磁気センサ、車速センサ、加速度センサなどへの実用化が急速に拡大している。

【 0 0 0 9 】

50 【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の

MIセンサは、検波用にショットキーバリアダイオードなどの高周波用ダイオードを使用しているため、例えば、自動車分野などへの応用に際して、センサの環境温度が大幅に変動する環境下では直流出力電圧が変動するという、温度特性の不安定性が解決すべき課題であることが判明した。

【0010】また、これまでのMIセンサでは、ヘッドにバイアス磁界を印加してリニア磁界センサを構成するため、消費電力が比較的大きくなる場合が多かった。

【0011】本発明は、上記問題点を除去し、温度特性の安定化を図るとともに、消費電力を減少させることができる磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサを提供することを目的とする。

【0012】

【課題を解決するための手段】本発明は、上記目的を達成するために、

〔1〕磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサにおいて、パルス通電電流で周回方向に励磁される高透磁率磁性体ヘッドと、この高透磁率磁性体ヘッドの周回方向に巻回されたコイルと、このコイルの誘起電圧の第1パルスを検出する電子スイッチとを具備するようにしたものである。

【0013】〔2〕上記〔1〕記載の磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサにおいて、前記高透磁率磁性体ヘッドはアモルファス磁性体を用いた磁性体ヘッドであることを特徴とする。

【0014】〔3〕上記〔2〕記載の磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサにおいて、前記アモルファス磁性体ヘッドはアモルファスワイヤであることを特徴とする。

【0015】〔4〕上記〔1〕、〔2〕又は〔3〕記載の磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサにおいて、前記高透磁率磁性体ヘッドは、周回方向に磁気異方性を持つヘッドであることを特徴とする。

【0016】〔5〕上記〔1〕記載の磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサにおいて、前記パルス通電電流は、前記高透磁率磁性体ヘッドに表皮効果を生じさせ、磁気インピーダンス効果を生じさせるようにしたものである。

【0017】〔6〕上記〔1〕記載の磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサにおいて、前記電子スイッチに接続されるアンプからのセンサ出力電圧に比例した電流を印加させ、外部磁界 H_{ex} を相殺する負帰還磁界を発生する帰還コイルとを具備するようにしたものである。

【0018】〔7〕上記〔1〕又は〔6〕記載の磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサにおいて、前記高透磁率磁性体ヘッドを2ヘッドとなし、コモンモード相殺効果による温度安定性を高めるようにしたものである。

【0019】

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。

【0020】まず、本発明の第1実施例について説明する。

【0021】図1は本発明の第1実施例を示す磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサ(MI)センサ回路の構成図である。

【0022】この図において、1は0磁歪アモルファスワイヤ、2はMI素子、3は Q_1 、 Q_2 、 Q_3 、 Q_4 、 Q_5 、 Q_6 （例えば、74AC04）のC-MOSインバータとCR微分回路からなる電源回路、4はアナログスイッチ（例えば、74HC4066）、5は0磁歪アモルファスワイヤ1の周回方向に巻回されたコイル、6はアンプ（例えば、AD524）、7は帰還コイル、 R_1 は510k、 R_2 は3k、 R_3 は200k、 R_4 は1、 R_5 は5.1k、 R_6 は2k、 R_7 は2k、 R_8 は3k、 C_1 、 C_2 、 C_3 、 C_4 は100pFである。

【0023】この図に示すように、この実施例の磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサ(MIセンサ)回路は、2mm長、30 μ m径の0磁歪アモルファスワイヤ1の両端に半田付けで電極を形成したMI素子2をヘッドとし、CMOSマルチバイブレータとCR微分回路からなる電源回路3で発生させた立ち上がり時間約5nsのパルス電流をMI素子2に印加し、このMI素子2の周回方向に巻回された40ターンのコイル5の誘起電圧を検出するように構成している。

【0024】上記0磁歪アモルファスワイヤ1は、厳密にはわずかに負の磁歪(-10^{-7})を持ち、張力アニールによって円周方向に異方性が誘導されているワイヤである。したがって、ワイヤ長さ方向の外部磁界 H_{ex} が0の場合は、ワイヤ1の通電パルス電流による磁束の変化は円周方向のみであって、ワイヤ1の周回方向に巻回されたコイル5との鎖交磁束が0であり、このコイル5の誘起電圧は0である。

【0025】外部磁界 H_{ex} が印加されると、ワイヤ1の磁化ベクトルがワイヤ軸方向に傾斜し、通電パルス電流による円周方向の磁界によって磁化ベクトルが円周方向に回転する。この時の磁束変化のワイヤ軸方向成分がコイル5と鎖交し、コイル5に誘起電圧が発生する。このコイル5の誘起電圧の符号は外部磁界 H_{ex} の符号と逆になる。ワイヤ1は表皮効果のため磁壁の移動が抑制され、磁化ベクトルの回転のみが生じる。この磁化動作のため、この回路構成におけるコイル5の誘起電圧は、従来のようにバイアス磁界を印加することなく、外部磁界 H_{ex} に比例した電圧となり、リニア磁界センサの特性を表す。

【0026】しかし、急峻なパルス電流による鎖交磁束の急激な変化のため、誘起電圧波形は純粋なパルス電圧波形でなく、コイル5の浮遊容量によるLC振動波形と

なる。この振動波形の第 1 パルス波形のみが外部磁界 H_{ex} に比例して高感度に変化するため、高感度磁界センサを構成するためには、第 1 のパルス波形のみを抽出する必要がある。ここでは、アナログスイッチ 4 によって、第 1 のパルス波形のみを抽出する。

【0027】図 2 は、縦軸をコイル誘起電圧の第 1 のパルスの高さをピークホールドした値 E_{out} 、横軸を印加磁界 H_{ex} とした実験結果を示す。 $|H_{ex}|$ を 0 から約 $1.20e$ まで増加させると、 E_{out} は H_{ex} に比例して増加し、 $|H_{ex}| > 1.20e$ までは E_{out} が減少している。

【0028】このアナログスイッチ 4 のトリガパルスは、ワイヤ通電パルスより進み位相にする必要があり、ワイヤ通電パルスは 2 個のインバータ (Q_3 , Q_4) を通して約 $10ns$ 遅らせるようにしている。

【0029】このコイル 5 の誘起パルス電圧の第 1 パルスの高さはピークホールド回路 (R_5 , C_4) で直流電圧に変換され、アンプ 6 でセンサ出力電圧となる。センサ出力電圧に比例した電流は、帰還コイル 7 に印加されて、外部磁界 H_{ex} を相殺する負帰還磁界を発生する。

【0030】この負帰還効果によって、図 3 に示すように、直線性の良いヒステリシスのない磁界センサ特性が得られる。

【0031】図 4 は本発明の第 1 実施例の磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサの出力電圧の温度特性温度特性を示す図であり、縦軸にセンサ出力電圧のドリフト率 (%)、横軸に温度 () を示している。

【0032】この図において、a は従来のショットキーバリアダイオードを用いた単ヘッドの MI センサの特性を、b は本発明の第 1 実施例の磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサによるコイル電圧検出形単ヘッド MI センサの温度特性の測定結果を示している。

【0033】センサ全体を電気炉に設置し、温度を室温から 80 まで上昇させた場合の、0 電圧の変化であり、本発明の MI センサでは、フルスケール電圧に対する 0 電圧の発生率が従来の MI センサの約 $1/5$ に減少していることが分かる。

【0034】次に、本発明の第 2 実施例について説明する。

【0035】図 5 は本発明の第 2 実施例を示す磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサ (MI センサ) 回路の構成図である。

【0036】この図において、11 は 0 磁歪アモルファスワイヤ、12 は MI 素子、13 は CMOS マルチパイプレータと CR 微分回路を含む電源回路、 Q_1 , Q_2 , Q_3 , Q_4 , Q_5 , Q_6 , Q_7 (例えば、74AC04) は C-MOS インバータを構成している。また、アナログスイッチ 14 (例えば、74HC4066)、コイル 15, 16, アンプ 17 (例えば、AD524)、帰還コイル 18, 19 を備えている。 R_1 は $5.1k$

、 R_2 は $3k$ 、 R_3 は 200 、 R_4 , R_5 は $51k$ 、 R_6 , R_7 は $2k$ 、 R_8 は $3k$ 、 C_1 , C_2 , C_3 , C_4 , C_5 は $100pF$ である。

【0037】この第 2 実施例では、第 1 実施例の MI センサ回路を 2 ヘッド回路に発展させて、コモンモードノイズを相殺することにより温度安定性の良いセンサを構成するようにしている。

【0038】図 6 は本発明の第 2 実施例の磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサの出力電圧の温度特性を示す図であり、縦軸にセンサ出力電圧のドリフト率 (%)、横軸に温度 () を示している。

【0039】この図において、a は従来のショットキーバリアダイオードを用いた単ヘッドの MI センサの特性を、b は本発明の第 1 実施例の磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサによるコイル電圧検出形単ヘッド MI センサの温度特性の測定結果を、c は本発明の第 2 実施例の磁気インピーダンス効果マイクロ磁気センサによるコイル電圧検出形 2 ヘッド MI センサの温度特性の測定結果をそれぞれ示している。

【0040】この図から明らかのように、2 ヘッド MI センサにより、コモンモード相殺効果による温度安定性が約 4 倍に向上した結果が得られた。 $30 \sim 75$ の温度変化における 0 電圧のドリフトは 0.4% であり、 $0.01\%FS/$ の高安定特性が実現された。

【0041】なお、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づいて種々の変形が可能であり、これらを本発明の範囲から排除するものではない。

【0042】例えば、パルス通電した MI 素子の両端間の電圧の第 1 パルスをアナログスイッチで抽出してピークホールドする MI センサも含まれる。

【0043】

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明によれば、次のような効果を奏することができる。

【0044】(A) 温度特性の安定化を図るとともに、消費電力を減少させることができる。

【0045】(B) 負帰還効果によって、直線性の良いヒステリシスのない磁界センサ特性を得ることができる。

【0046】(C) コモンモード相殺効果による温度安定性の向上を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】本発明の第 1 実施例を示す磁気インピーダンス効果マイクロ磁気 (MI) センサ回路の構成図である。

【図 2】本発明の第 1 実施例を示すコイルパルス電圧対磁界の特性図である。

【図 3】本発明第 1 実施例を示す磁気インピーダンス効果マイクロ磁気 (MI) センサによる磁界 ($\pm 10e$, $100Hz$) 検出の特性図である。

【図 4】本発明の第 1 実施例を示す磁気インピーダンス

効果マイクロ磁気 (MI) センサの出力電圧の温度特性を示す図である。

【図5】本発明の第2実施例を示す磁気インピーダンス効果マイクロ磁気 (MI) センサ回路の構成図である。

【図6】本発明の第2実施例を示す磁気インピーダンス効果マイクロ磁気 (MI) センサの出力電圧の温度の特性図である。

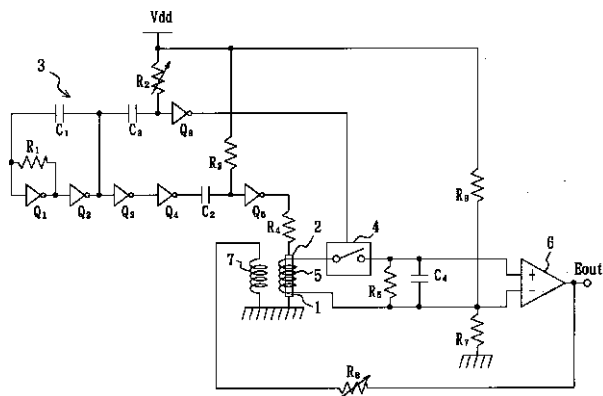
【符号の説明】

Q₁ , Q₂ , Q₃ , Q₄ , Q₅ , Q₆ , Q₇ C - M

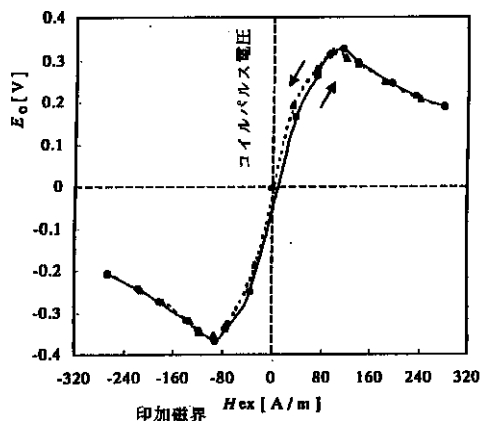
OSインバータ

- 1, 11 0磁歪アモルファスワイヤ
- 2, 12 MI素子(ヘッド)
- 3, 13 電源回路
- 4, 14 アナログスイッチ
- 5, 15, 16 コイル
- 6, 17 アンプ
- 7, 18, 19 帰還コイル

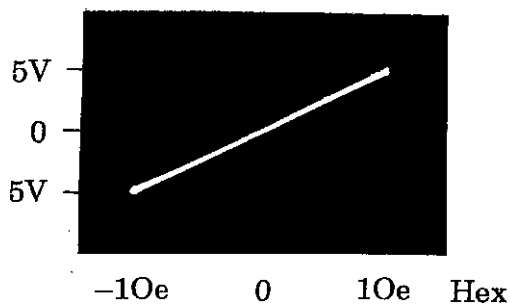
【図1】



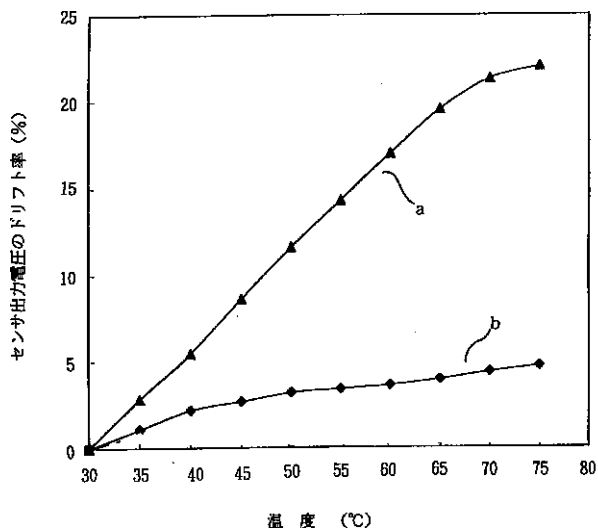
【図2】



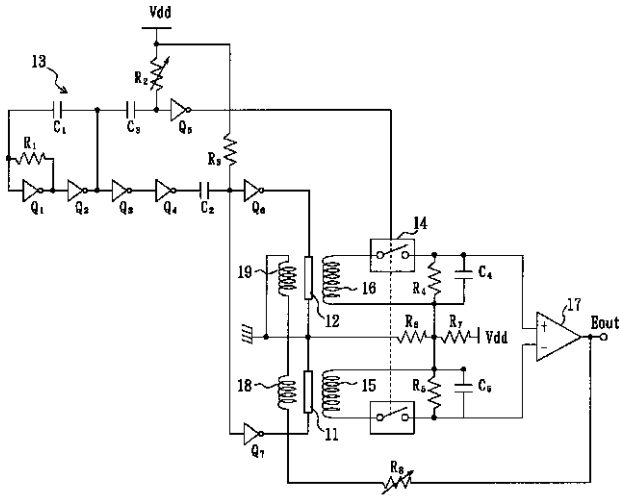
【図3】



【図4】



【図5】



【図6】

